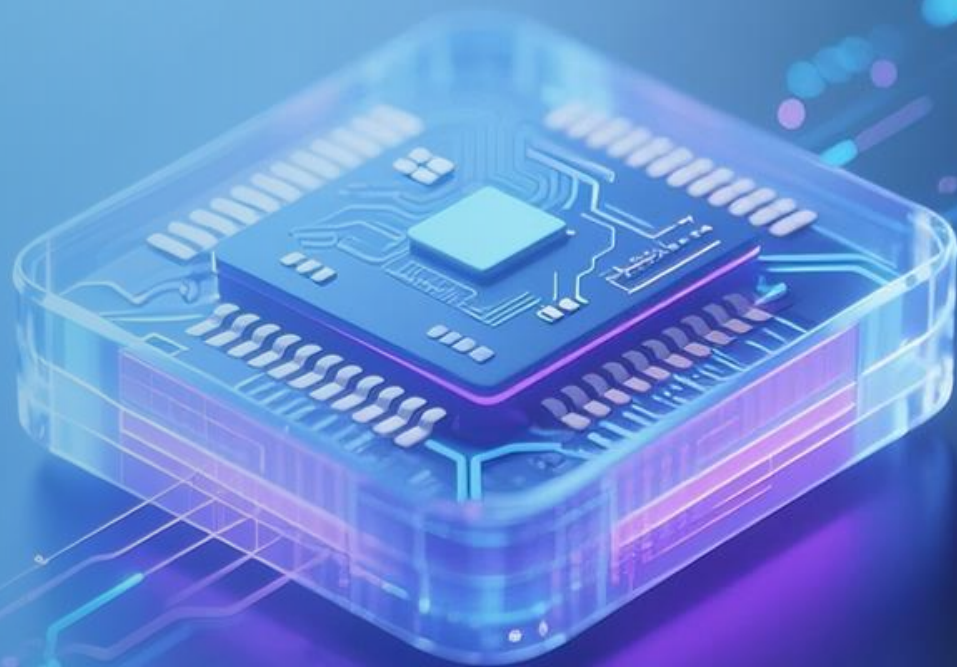


# AI算力革命与存储 芯片超级周期

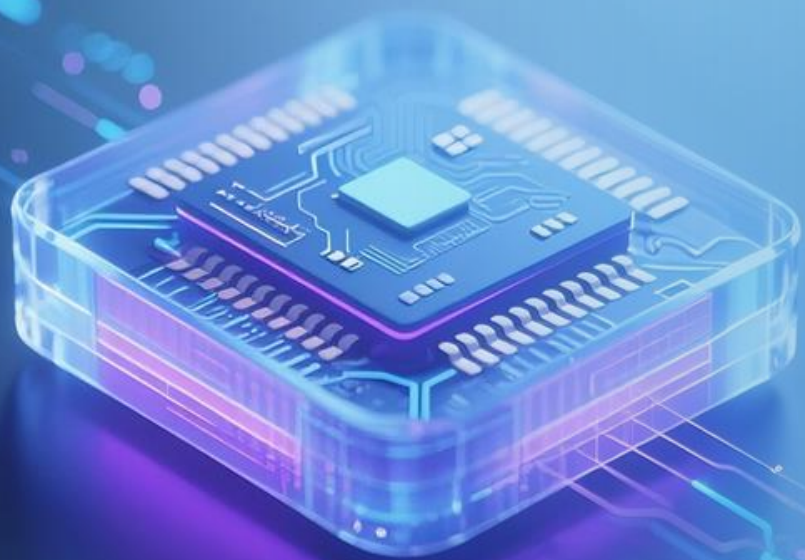
2026年全球存储芯片市场深度解析

北京研精毕智信息咨询有限公司



# 目录





# 市场规模与价格波动

2026年全球存储芯片行业迎来历史性转折，市场规模与价格双双爆发，进入由AI主导的超级景气周期，彻底颠覆了传统周期逻辑。

# 市场规模爆发式增长



## 1 市场规模突破1800亿

2026年全球存储芯片整体市场规模预计将达到1800亿美元，同比增速突破40%，创下近十年最高增长纪录。

## 2 增长动力结构分化

与过去依赖消费电子的平稳增长不同，本轮增长的核心驱动力是AI算力需求，其确定性更强、增速更高。

## 3 行业地位显著提升

存储芯片占全球半导体市场的份额预计将达到30.2%，超越晶圆代工，成为半导体领域占比最高的细分品类。

**全球存储芯片市场规模预计在2026年突破1800亿美元，同比增长超40%，正式迈入由AI算力驱动的全新增长周期。**



# DRAM价格历史性暴涨

DRAM作为存储核心品类，2026年一季度全球合约价格环比涨幅突破90%，部分主流颗粒价格实现数倍增长，创成熟半导体品类罕见记录。

1

## 一季度环比涨90%+

2026年第一季度，全球DRAM合约价格环比涨幅已突破90%，市场呈现供不应求的极端紧张局面。

2

## 部分型号单月翻倍

部分主流DDR5高速颗粒价格从年初的4.68美元暴涨至34.08美元，单月涨幅突破100%，价格实现跨越式飙升。

3

## 全年涨幅预期超250%

预计2026年全年DRAM市场整体价格涨幅将达到250%-280%，细分市场规模有望突破1100亿美元。



# NAND闪存同步飙升

NAND闪存市场涨价节奏与DRAM同步共振，企业级高端产品涨幅更为突出，一季度价格环比整体涨幅区间维持在55%-90%。

01

## 一季度环比涨55%-90%

2026年Q1全球NAND闪存合同价格普遍上涨，其中高端企业级型号价格涨幅逼近100%，供需矛盾集中爆发。

03

## 二季度预计再涨70%+

预计2026年Q2 NAND闪存价格将延续强势，预计再度上涨70%-75%，涨价趋势贯穿上半年且无回落迹象。

## 企业级产品涨幅领先

适配AI数据中心、高端服务器的高容量企业级NAND型号价格涨幅最为显著，高端产能紧缺局面彻底爆发。

02



# 史诗级供需失衡

本轮涨价的核心底层逻辑是供需格局的极端失衡，2026年全球存储芯片整体供需缺口创下近十五年新高，结构性紧缺特征极其显著。

1

**DRAM供需缺口达  
4.9%**

全球DRAM市场全年供需缺口预计达到4.9%，作为AI服务器核心配套的HBM供需缺口更是高达5.1%。

2

**NAND供需缺口超  
4.2%**

常规消费级与企业级NAND闪存的供需缺口预计为4.2%，高端企业级SSD产能尤其紧张。

3

**头部产能完全锁定**

三星、SK海力士、美光三大巨头已宣布2026年全年产能100%售罄，无任何空余产能承接市场新增需求。

4

**中小客户“一货难求”**

数量庞大的中小终端厂商面临“有钱也买不到货”的困境，市场现货稀缺、期货排期大幅拉长。





# 供需格局重构

本轮超级周期的根本原因在于AI需求爆发与厂商产能战略转移的叠加效应，导致行业供需格局发生结构性重构，告别传统周期逻辑。

# AI算力重塑需求



AI算力产业的爆发式增长彻底颠覆了行业原有需求结构，从传统消费电子驱动转向AI算力驱动，成为本轮涨价的核心引擎。

## 1 AI服务器需求激增

单台AI训练服务器的DRAM配置量是传统服务器的8-10倍，NAND闪存用量达到3倍以上，存储成本占比从20%飙升至35%。

## 2 头部企业锁定产能

全球70%以上的先进制程存储产能被头部AI数据中心锁定，谷歌、微软、阿里等巨头已完成全年产能提前锁单。

## 3 AI推理场景爆发

AI产业重心从模型训练向推理场景规模化落地转移，将带来更持续、更普惠的存储需求，进一步加剧行业供需矛盾。



# 厂商逆周期减产

面对AI需求爆发，三大存储寡头并未扩产增收，反而采取逆周期减产、高端化转型的经营策略，主动收缩传统产能，加剧行业短缺。

01

## 三星SK海力士减产

三星将NAND闪存年度晶圆产量从490万片下调至468万片，SK海力士从190万片下调至170万片，合计减产6.2%。

02

## 扩产节奏远慢需求

2026年全球DRAM行业资本支出同比增长仅14%，远低于历史景气周期30%-50%的水平，无法匹配爆发式需求。

03

## 产线升级挤压供给

原厂持续推进产线升级，淘汰老旧DDR4产线，将资源全面转移至HBM、DDR5等高端产线，导致消费级供给持续收缩。





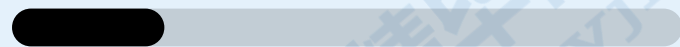
# 产业链传导效应

存储芯片作为核心元器件，其价格暴涨的压力正沿着产业链条自上而上传导，深刻影响着从上游原厂到终端消费市场的每一个环节。

# 上游原厂寡头垄断

全球存储芯片上游呈现高度寡头垄断格局，三大国际巨头牢牢掌控全球供给与定价话语权，并进一步强化其垄断优势。

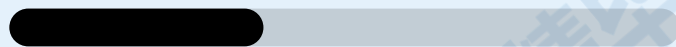
01



## DRAM市场垄断超95%

三星、SK海力士、美光合计占据全球DRAM市场95%以上的份额，在NAND闪存市场合计份额也接近70%。

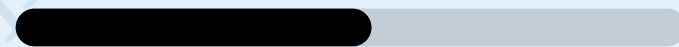
02



## 产能分配向头部倾斜

原厂产能分配全面向谷歌、微软、阿里等头部AI大客户倾斜，优先保障高端存储订单，压缩中小客户订单。

03



## 行业马太效应加剧

头部AI巨头货源充足，中小厂商则面临价格暴涨、交付延期、缺货断供等一系列问题，生存空间被持续压缩。

# 中游封测业绩爆发

在行业高景气、产品涨价、国产替代加速的多重红利叠加下，国内存储中游封测、模组制造企业迎来历史性业绩爆发期。

## 01

### 国产企业高速增长

2026年国内存储封测行业市场规模预计突破150亿美元，同比增速超过50%，远高于全球平均水平。

## 02

### 佰维存储净利润暴增

头部企业佰维存储一季度净利润高达28.99亿元，同比暴增341%，业绩创行业标杆，主要受益于AI算力产业爆发。

## 03

### 业绩增长成行业缩影

佰维存储的爆发并非个例，国内一众存储封测、模组厂商均同步受益于行业缺货涨价与海外订单转移，利润水平大幅提升。

# 终端市场全面涨价



上游存储芯片价格暴涨的成本已全面传导至手机、PC、笔记本等终端消费市场，消费电子行业正式进入“高成本、高售价”的新阶段。

## 01

### 终端产品集体涨价

2026年开年以来，国内主流中端智能手机集体涨价200-400元，PC市场的内存条、SSD价格也持续走高。

## 02

### 头部厂商预警涨价

小米集团创始人雷军公开表示，未来两年内存、闪存价格将持续上涨，手机售价必然同步上涨，消费电子涨价是长期趋势。

## 03

### 消费者成本显著增加

终端涨价直接增加了消费者的购机成本，市场普遍调侃“内存比黄金更保值”，行业进入高成本时代。





# 行业风险与挑战

本轮超级周期在带来巨大机遇的同时，也暴露了全球存储产业的深层次矛盾与系统性风险，行业未来发展面临多重挑战。

# 供应链高度集中风险

全球存储产业高度集中，行业发展高度依赖少数海外巨头，供应链稳定性、安全性、抗风险能力存在显著短板。

1

三大原厂主导市场

三星、SK海力士、美光的产能调整与定价策略直接决定了全球市场的供给格局与价格走势，行业缺乏有效制衡力量。

2

地缘政治冲击显著

全球地缘政治局势复杂多变，国际贸易壁垒、技术制裁等风险频发，一旦出现突发状况，全球供应链将面临剧烈冲击。

3

中小客户抗风险弱

行业供应链分层明显，中小客户无稳定货源渠道，只能被动接受价格上涨、交付延期的现状，整体抗风险能力偏弱。



# 产能结构性错配



原厂资源向高端产品倾斜，导致行业出现“高端产能逐步过剩、低端产能持续紧缺”的结构性产能错配矛盾。

## 01

### 高端产能高速扩容

三大原厂将绝大部分资源投向HBM、高端企业级SSD等高附加值产品，高端产能同比增长超60%。

## 02

### 低端产能持续收缩

传统DDR4、消费级NAND等通用型存储产品的扩产动力严重不足，产能增速不足10%，导致消费级市场短缺问题持续加剧。

## 03

### 行业波动幅度放大

结构性错配导致行业供需波动幅度持续放大，彻底告别传统平稳周期，进入高波动、强分化的发展阶段。



# 终端需求抑制风险

存储芯片价格持续上行，导致终端产品售价走高，将反过来压制终端消费需求的释放，对存量市场形成明显冲击。

1

## 终端涨价抑制消费

手机、PC等终端产品价格持续走高，直接压制了消费者的换机意愿，加剧了终端需求疲软态势。

2

## 形成反向循环逻辑

行业可能形成“芯片价格上涨—终端产品涨价—消费需求下滑—终端库存积压—芯片价格回落”的反向循环，超级周期存在阶段性反转风险。



# 未来趋势展望

展望未来，AI驱动的结构化分化、国产替代的加速推进以及全球供应链的重构将成为行业发展的核心主线，技术创新仍是竞争关键。

# 结构性分化持续

未来数年，适配AI算力场景的高端存储产品将持续处于供不应求的紧缺状态，而传统消费级存储将持续面临双重压力。

01

## 高端存储持续紧缺

HBM高带宽内存、企业级大容量SSD等高端产品将成为行业营收与利润增长的核心引擎，价格与毛利率维持高位。

02

## 消费级市场承压

传统消费级存储产品将持续面临需求疲软、产能收缩、价格高波动的双重压力，行业结构性分化行情将长期延续。



# 国产替代全面加速

以长江存储、长鑫存储为代表的国产核心晶圆厂商将持续突破，国内存储产业链的技术自主性与市场话语权将持续提升。

1

## 国产力量持续崛起

长江存储全球NAND份额已突破13%，长鑫存储在DRAM领域加速突破，国产替代将贯穿未来数年行业发展全程。

2

## 打破国际垄断格局

国内企业将逐步打破三星、美光等国际寡头的垄断，构建更加安全、可控的本土化供应链体系。



# 供应链安全成主流

在多重风险驱动下，全球上下游企业将高度重视供应链安全建设，彻底改变单一依赖海外三大原厂的采购模式。

01

## 多元化采购策略

企业将通过多源采购、国产替代、区域化产能布局、战略合作锁产等多种方式，降低单一供应链风险。

02

## 提升全球供应链韧性

构建更加稳定、更具抗风险能力的全球存储供应链体系，成为行业长期发展的必然趋势。

# 技术迭代聚焦核心

未来存储技术研发方向将告别单纯的制程微缩，转向带宽提升、功耗降低、密度升级三大核心赛道，先进封装成为竞争焦点。

## 研发方向全面升级

技术迭代向高带宽、低功耗、高密度方向集中，3D NAND堆叠层数持续突破，HBM技术快速迭代。

## 先进封装成竞争核心

先进封装技术将成为国内外厂商差异化竞争的核心赛道，其技术壁垒将决定企业的长期行业地位。



## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司(简称为“研精毕智”)所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。

本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测行业未来的发展趋势。

我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用和修改。

本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。